

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-332343

(P2000-332343A)

(43) 公開日 平成12年11月30日 (2000. 11. 30)

(51) Int.Cl.	識別記号	F I	テグト (参考)
H 0 1 S	5/042	H 0 1 S 3/18	6 2 4 5 F 0 4 1
H 0 1 L	21/52	H 0 1 L 21/52	D 5 F 0 4 7
			B 5 F 0 7 3
			E
	33/00	33/00	

審査請求 未請求 請求項の数17 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願平11-140948

(22) 出願日 平成11年5月21日 (1999. 5. 21)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 伊藤 茂穂

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74) 代理人 100103296

弁理士 小池 隆彌

Fターム (参考) 5F041 AA33 AA41 CA04 CA05 CA34

CA46 CA82 CA85 CA86 CA87

CA92 CA98

5F047 AA19 BA08 BA17 CA08

5F073 AA13 AA45 AA74 CA17 CB05

CB22 CB23 DA30 DA34 FA14

(54) 【発明の名称】 半導体発光装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 熱抵抗が劣化せず、しかも、チップ分割工程の生産性の良い半導体レーザー装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体レーザー装置の製造方法において、透明な基板とその上に設けられた半導体積層体を備えた半導体発光素子ウェハの基板下面に、ウェハ裏面側からウェハ表面の構造が透かして確認できる膜厚の、順次第1の金属膜と第2の金属膜とからなる多層金属膜を形成する工程と、ウェハ裏面側からウェハ表面の構造を認識してアライメントすることによりウェハ裏面に分割溝を形成してウェハを分割し、半導体発光素子チップを得る工程と、前記半導体発光素子チップを基板側を下にし、ハンダを介して支持基体上に積載し、加熱することにより、前記第1の金属膜を膜状に残存させ、かつ、前記第2の金属膜はハンダに溶かし込む工程を有することにより、上記課題を解決する。

